
	<h2>RS3E095BNGZETB</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> RS3E095BNGZETB</p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> NCH 30V 9.5A MIDDLE POWER MOSFET</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">RS3E095BNGZETB.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	






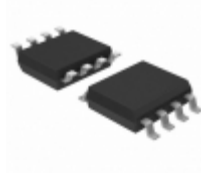
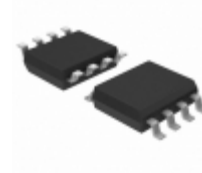

### Spezifikationen

Teilenummer	RS3E095BNGZETB
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	NCH 30V 9.5A MIDDLE POWER MOSFET
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SOP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14.6 mOhm @ 9.5A, 10V
Verlustleistung (max)	2W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	680pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16.3nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.5A (Tc)

RS3E095BNGZETB Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RS3E095BNGZETB-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RS3E095BNGZETB LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ RS3E095BNGZETB E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>RS3DHR7G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 200V 3A DO214AB</p>	 <p><b>RS3E075AT</b> ROHM RS3E075AT ROHM</p>	 <p><b>RS3G</b> Original RS3G Original</p>	 <p><b>RS3E095BN</b> ROHM RS3E095BN ROHM</p>
 <p><b>RS3E871-E2</b> ROHM ROHM TSOP-28</p>	 <p><b>RS3E135BNGZETB</b> Rohm Semiconductor NCH 30V 13.5A MIDDLE POWER MOSFE</p>	 <p><b>RS3E075ATTB</b> Rohm Semiconductor MOSFET P-CH 30V 7.5A 8SOP</p>	 <p><b>RS3E135BN</b> ROHM ROHM SOP8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RS3E095BNGZETB LAPIS Semiconductor	RS3E095BNGZETB Datenblatt	RS3E095BNGZETB-Datenblätter	RS3E095BNGZETB PDF	LAPIS Semiconductor
RS3E095BNGZETB Electronic	RS3E095BNGZETB-Komponenten	RS3E095BNGZETB-Verteiler	RS3E095BNGZETB-Bild	RS3E095BNGZETB-Teil
RS3E095BNGZETB Preis	RS3E095BNGZETB Hersteller	RS3E095BNGZETB Bild	RS3E095BNGZETB Aktie	RS3E095BNGZETB Inventar
RS3E095BNGZETB Neu	RS3E095BNGZETB Original	RS3E095BNGZETB garantiert	RS3E095BNGZETB RFQ	RS3E095BNGZETB Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited